

Benutzerdefinierter Ptfе-Reinigungskorb Für Halbleiterwafer - Korrosionsbeständig, Geringer Untergrund, Laborgestell

Artikelnummer: PL-CP267



Einführung

Erreichen Sie höchste Reinheit in der Halbleiterfertigung mit unseren maßgefertigten PTFE-Reinigungskörben. Konstruiert für extreme chemische Beständigkeit und geringe Untergrundstörungen, sorgen diese langlebigen Gestelle für eine effiziente Waferverarbeitung, schnelle Entwässerung und zuverlässige Leistung in kritischen Reinraumlaboren.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
RCA-Reinigungsprozess	Verwendet während SC-1- und SC-2-Sequenzen, um organische Rückstände und metallische Verunreinigungen von Siliziumwafern zu entfernen.	Verhindert Rekontamination durch die ultrareine, Materialoberfläche mit geringer Auswaschung.
Piranha-Ätzen	Handhabung von Wafern in einer Mischung aus Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid zur Entfernung von Fotolack.	Außergewöhnliche Beständigkeit gegen aggressive oxidative Umgebungen ohne strukturellen Abbau.
Flusssäure-Bad	Entfernen von nativen Oxidschichten von Siliziumsubstraten unter Verwendung von konzentrierten oder gepufferten HF-Lösungen.	Vollständige Immunität gegen HF-Angriff, gewährleistet langfristigen Geräteschutz und Prozessreinheit.
Nach-CMP-Spülung	Reinigen von Wafern nach chemisch-mechanischem Polieren (CMP), um Schlickerpartikel und Chemikalien zu entfernen.	Schnelle Entwässerung und Antihaf-Eigenschaften verhindern, dass Schlickerpartikel am Korb haften bleiben.
Fotolithografie-Entwicklung	Unterstützung von Substraten während der Entwicklung und des Strippen von Fotolackschichten.	Hohe Dimensionsstabilität sorgt für präzise Ausrichtung und Handhabung während kritischer Lithografieschritte.
Vorbereitung der Spurenanalyse	Reinigen von Laborgeräten und Behältern, die in ICP-MS und anderen hochsensiblen Analysentechniken verwendet werden.	Extrem niedrige Untergrundwerte gewährleisten die höchste Genauigkeit bei der Erkennung von metallischen Spurenverunreinigungen.
GaAs-Wafer-Verarbeitung	Handhabung von Verbindungshalbleiter-Wafern durch spezialisierte Ätz- und Spülzyklen.	Schonende Stützstrukturen verhindern Bruch von spröden Verbindungshalbleiter-Materialien.
Ultraschallreinigung	Funktioniert als untergetauchter Träger während hochfrequenter akustischer Reinigungszyklen.	Überträgt Ultraschallenergie effizient und schützt Wafer vor mechanischem Kontakt mit dem Tank.

Funktion	Spezifikationsdetails für PL-CP267
Modellkennung	PL-CP267
Primäres Material	Hochreines PTFE (Polytetrafluorethylen)
Fertigungsverfahren	100 % präzisions-CNC-gefräst (keine Spritzgussrückstände)
Chemische Beständigkeit	Volle Beständigkeit gegen HF, H ₂ SO ₄ , HNO ₃ , HCl, KOH und organische Lösungsmittel
Temperaturbereich	-200 °C bis +260 °C (-328 °F bis +500 °F)
Oberflächenfinish	Glattes, niedrigporöses Finish zur Minimierung des Einfangens von Partikeln
Konfigurationsoptionen	Vollständig anpassbar (Wafergröße, Schlitzbreite, Schlitzteilung, Griffdesign)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Funktion	Spezifikationsdetails für PL-CP267	
Wafer-Kompatibilität	Geeignet für 2", 3", 4", 6", 8" und 12" Wafer oder kundenspezifische Abmessungen	
Entwässerungsdesign	V-förmige oder U-förmige Schlitzprofile verfügbar für optimierten Flüssigkeitsablauf	
Untergrundwerte	Speziell verarbeitet für Anforderungen an metallische Verunreinigungen im Sub-ppb-Bereich	